

КТ3128А1,Б1

**PNP КРЕМНИЕВЫЙ ЭПИТАКСИАЛЬНО – ПЛАНАРНЫЙ
ТРАНЗИСТОР МАЛОЙ МОЩНОСТИ**

АДБК.432143.026ТУ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АППАРАТУРЕ ШИРОКОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

* Изготавливается в корпусе **КТ-26 (ТО-92)**.



1–Коллектор, 2–База, 3–Эмиттер

ПРЕДЕЛЬНО- ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры	Обозначение	Ед. измер.	Значение
Напряжение коллектор-база	Uкб max	В	40
Напряжение коллектор-эмиттер	Uкэо max	В	35
Напряжение эмиттер-база	Uэб max	В	4
Постоянный ток коллектора	Iк max	мА	30
Ток базы	Iб max	мА	5
Температура перехода	Tj	°С	150
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора	Pк max	Вт	0,3

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (Токр.ср.=25°С)

Параметры	Обозначение	Ед. измер	Режимы измерения	Min	Max
Обратный ток коллектора	Iкбо	мкА	Uкб=20В	-	0,1
Статический коэффициент передачи тока	h21E		Uкб=10В, Iэ=3мА f=50Гц		
	КТ3128А1			35	150
	КТ3128Б1			25	200
Емкость коллекторного перехода*	Ск*	пФ	Uкб=10В f=10 ⁷ Гц	-	1
Емкость эмиттерного перехода*	Сэ*	пФ	Uэб=2В f=10 ⁷ Гц	-	1,5
Граничная частота коэффициента передачи тока*	Fгр*	МГц	Uкб=10В f=10 ⁸ Гц Iэ=2мА	800	-

* справочные параметры

220108, г. Минск, ул. Корженевского, 16, УП "Завод ТРАНЗИСТОР"

Отдел маркетинга: тел./факс (10-37517) 212-59-32

E-mail: market@transistor.com.by <http://www.transistor.by>